



DAYA

臺源國際股份有限公司

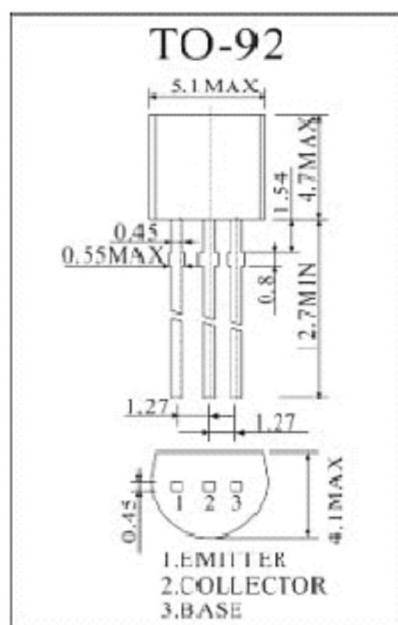
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors

C1815

—NPN silicon—

■绝对最大额定值 (Ta=25°C)

项 目	符 号	额 定 值	单 位
集电极—基极电压	V _{CB0}	60	V
集电极—发射极电压	V _{CE0}	50	V
发射极—基极电压	V _{EB0}	5	V
集电极电流	I _c	150	mA
集电极耗散功率	P _c	400	mW
结 温	T _j	150	°C
存储温度	T _{stg}	- 55~150	°C



■电参数 (Ta=25°C)

项 目	符 号	最 小 值	典 型 值	最 大 值	单 位	测 试 条 件
直流电流增益	h _{FE}	70		700		V _{CE} = 6 V, I _c = 2 mA
集电极-基极截止电流	I _{CB0}			0.1	μ A	V _{CB} = 60 V, I _E =0
发射极-基极截止电流	I _{EB0}			0.1	μ A	V _{EB} = 5 V, I _c =0
集电极-基极击穿电压	BV _{CB0}	60			V	I _c = 0.02 mA, I _E =0
集电极-发射极击穿电压	BV _{CE0}	50			V	I _c = 1 mA, I _B =0
发射极-基极击穿电压	BV _{EB0}	5			V	I _E = 0.02 mA, I _c =0
集电极-发射极饱和压降	V _{CE(sat)}		0.1	0.25	V	I _c = 100 mA, I _B = 10 mA
基极-发射极饱和压降	V _{BE(sat)}			1	V	I _c = 100 mA, I _B = 10 mA
电流增益-带宽乘积	f _T	80			MHz	I _c = 1 mA, V _{CE} = 10 V
共基极输出电容	C _{ob}		2	3.5	PF	V _{CB} = 10 V, I _E =0, f= 1MHz
噪声系数	N _F		1	10	dB	V _{CE} =6V, I _c =0.1mA, f=1KHz, R _g =10K Ω

■h_{FE} 分档及其标志

分 档	O	Y	GR	BL
h _{FE}	70~140	120~240	200~400	350~700